

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年12月22日(2016.12.22)

【公開番号】特開2014-116592(P2014-116592A)

【公開日】平成26年6月26日(2014.6.26)

【年通号数】公開・登録公報2014-033

【出願番号】特願2013-233600(P2013-233600)

【国際特許分類】

H 01 L	29/786	(2006.01)
H 01 L	21/336	(2006.01)
H 01 L	29/417	(2006.01)
H 01 L	29/41	(2006.01)
H 01 L	21/28	(2006.01)
H 01 L	21/283	(2006.01)
G 02 F	1/1368	(2006.01)

【F I】

H 01 L	29/78	6 1 6 T
H 01 L	29/78	6 1 8 B
H 01 L	29/78	6 1 9 A
H 01 L	29/50	M
H 01 L	29/44	P
H 01 L	29/44	L
H 01 L	21/28	3 0 1 B
H 01 L	21/283	C
G 02 F	1/1368	

【手続補正書】

【提出日】平成28年10月27日(2016.10.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1のトランジスタを有し、

前記第1のトランジスタは、第1の配線への第1の信号の供給を制御する機能を有し、

前記第1の配線は、画素に電気的に接続されており、

前記第1のトランジスタは、

ゲート電極と、

前記ゲート電極上の酸化物半導体膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電気的に接続されている第1の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電気的に接続されている第2の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上、前記第1の導電膜上、及び前記第2の導電膜上の金属酸化物膜と、を有し、

前記第1の導電膜は、前記酸化物半導体膜と重なる第1の領域を有し、

前記酸化物半導体膜は、チャネル幅方向において前記第1の領域よりも幅の広い第2の

領域を有し、

前記金属酸化物膜に含まれる一の金属元素は、前記酸化物半導体膜に含まれる一の金属元素と同じである半導体装置。

【請求項 2】

第1のトランジスタ乃至第3のトランジスタを有し、

前記第1のトランジスタは、第1の配線への第1の信号の供給を制御する機能を有し、

前記第2のトランジスタは、第2の配線への前記第1の信号の供給を制御する機能を有し、

前記第3のトランジスタは、前記第1のトランジスタのゲート電極への第1の電位の供給を制御する機能と、前記第2のトランジスタのゲート電極への前記第1の電位の供給を制御する機能と、を有し、

前記第1の配線は、画素に電気的に接続されており、

前記第1のトランジスタ乃至前記第3のトランジスタは、

酸化物半導体膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電気的に接続されている第1の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上において前記酸化物半導体膜に電気的に接続されている第2の導電膜と、

前記酸化物半導体膜上、前記第1の導電膜上、及び前記第2の導電膜上の金属酸化物膜と、をそれぞれ有し、

前記第1の導電膜は、前記酸化物半導体膜と重なる第1の領域を有し、

前記酸化物半導体膜は、チャネル幅方向において前記第1の領域よりも幅の広い第2の領域を有し、

前記金属酸化物膜に含まれる一の金属元素は、前記酸化物半導体膜に含まれる一の金属元素と同じである半導体装置。